

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
【部門区分】第6部門第4区分  
【発行日】平成17年6月30日(2005.6.30)

【公開番号】特開2003-151128(P2003-151128A)  
【公開日】平成15年5月23日(2003.5.23)  
【出願番号】特願2001-341570(P2001-341570)  
【国際特許分類第7版】  
G 1 1 B 5/851  
G 1 1 B 5/667  
【F I】  
G 1 1 B 5/851  
G 1 1 B 5/667

【手続補正書】  
【提出日】平成16年10月21日(2004.10.21)  
【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書  
【補正対象項目名】特許請求の範囲  
【補正方法】変更

【補正の内容】  
【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に軟磁性層を形成する方法において、該基板に直流バイアス電圧を加えながらスパッタリングを行うことを特徴とする軟磁性層を形成した基板の製造方法。

【請求項2】

直流バイアス電圧が50V以上かつ500V以下である請求項1の軟磁性層を形成した基板の製造方法。

【請求項3】

請求項1または2に記載の方法により形成されたことを特徴とする軟磁性層を形成した基板。

【請求項4】

軟磁性層の保磁力が100e(790A/m)以下である請求項3に記載の軟磁性層を形成した基板。

【請求項5】

軟磁性層が少なくともFeNi、ないしCoZrX(XはNb、Taより選ばれる一種以上の元素)を含有することを特徴とする請求項3または4に記載の軟磁性層を形成した基板。

【請求項6】

請求項3乃至5のいずれかに記載の軟磁性層上に少なくとも磁気記録層が形成されてなる磁気記録媒体。

【請求項7】

磁気記録層が垂直磁化膜である請求項6に記載の磁気記録媒体。

【請求項8】

基板上に軟磁性層、磁気記録層を含む磁気記録媒体の製造方法であって、基板に直流バイアス電圧を加えながらスパッタリングを行うことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項9】

直流バイアス電圧が50V以上かつ500V以下である請求項8に記載の磁気記録媒体の製造方法。

【請求項10】

請求項 6 または 7 に記載の磁気記録媒体と、磁気記録媒体を記録方向に駆動する駆動部と、記録部と再生部からなる磁気ヘッドと、磁気ヘッドと磁気記録媒体に対して相対移動させる手段と、磁気ヘッドの記録信号入力と磁気ヘッドからの再生信号出力を行うための記録信号処理手段を有することを特徴とする磁気記録装置。